

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

105-2-03-4

105-2-04-4

105 學年度科技校院四年制與專科學校二年制  
統一入學測驗第二次聯合模擬考試題本

電機與電子群電機類  
電機與電子群資電類

專業科目(一)：電子學、基本電學

【注意事項】

1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷分兩部份，共 50 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。  
第一部份(第 1 至 25 題，每題 2 分，共 50 分)  
第二部份(第 26 至 50 題，每題 2 分，共 50 分)
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有(A)、(B)、(C)、(D)四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

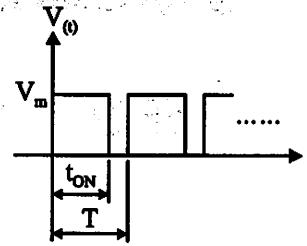
准考證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

## 第一部分：電子學

1. 如圖(一)所示為交流週期波形，其工作週期為 75%，若電壓的平均值為 12 V，試求電壓的有效值為何？

- (A) 8 V
- (B) 4 V
- (C)  $8\sqrt{3}$  V
- (D)  $4\sqrt{3}$  V



圖(一)

2. 砷(Si)與鎵(Ge)元素皆為半導中常使用的材料，有關兩元素之比較，下列何者錯誤？

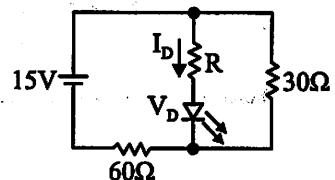
- (A) 砷(Si)元素材料取得較易，且價格低廉
- (B) 鎵(Ge)元素耐溫度較高
- (C) 砷(Si)元素耐電壓較高
- (D) 鎵(Ge)元素漏電流較大

3. 有關半導體之敘述，下列何者正確？

- (A) 雜質濃度愈高，電阻愈低，耐壓愈高
- (B) 環境溫度愈高，導電性下降
- (C) 在 N 型半導體中，電子濃度隨溫度的升高而減少
- (D) N 型半導體之費米能階較靠近導帶

4. 如圖(二)所示之電路，發光二極體之順向導通電壓  $V_D = 1.6$  V，導通電流  $I_D = 17$  mA，若依前述之工作條件使其發光，則電阻值 R 為何？

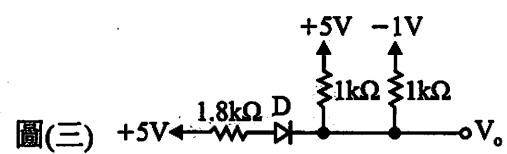
- (A)  $180\Omega$
- (B)  $220\Omega$
- (C)  $300\Omega$
- (D)  $330\Omega$



圖(二)

5. 如圖(三)所示之電路，二極體 D 之切入電壓  $V_f = 0.7$  V，順向電阻  $r_p = 200\Omega$ ，逆向電阻  $r_R = \infty$ 。試求輸出電壓  $V_o$  約為何？

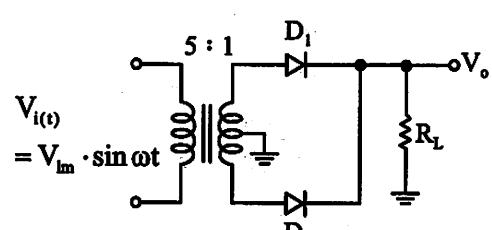
- (A) 1.5 V
- (B) 2.5 V
- (C) 3.5 V
- (D) 5.5 V



圖(三)

6. 如圖(四)所示之電路，若輸出電壓平均值  $V_{o(dc)} = 20$  V，

- 試求輸入電壓  $V_i(t) = ?$
- (A)  $31.4\sin\omega t$
  - (B)  $62.8\sin\omega t$
  - (C)  $157\sin\omega t$
  - (D)  $314\sin\omega t$



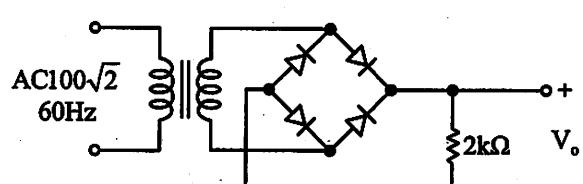
圖(四)

7. 如圖(五)所示之電路，若二極體為理想，

- 且  $PIV = 10\sqrt{2}$  V，試求輸出電壓平均值

- $V_{o(dc)}$  約為何？

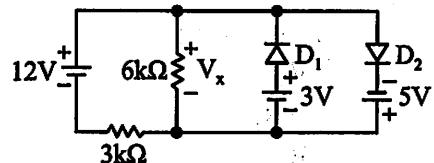
- (A) 9 V
- (B) 7 V
- (C) 5 V
- (D) 3 V



圖(五)

8. 如圖(六)所示之電路，若二極體  $D_1$ 、 $D_2$  之切入電壓為  $0.6\text{ V}$ ，順向電阻  $r_f \approx 0\Omega$ ，試求電阻值  $6\text{ k}\Omega$  兩端之電壓值  $V_x$  為何？

- (A)  $-5.6\text{ V}$
- (B)  $-5\text{ V}$
- (C)  $-4.4\text{ V}$
- (D)  $3.6\text{ V}$



圖(六)

9. 電晶體放大電路中有三種基本組態：CE(共射極)、CC(共集極)、CB(共基極)。試問具有最高電壓增益與功率增益者分別為何？

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (A) CE、CB | (B) CE、CE |
| (C) CB、CC | (D) CB、CE |

10. 有關電晶體  $\alpha$  與  $\beta$  的關係，下列何者正確？

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| (A) $\frac{1}{\beta} = 1 - \frac{1}{\alpha}$ | (B) $\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$ | (C) $\alpha = \frac{\beta}{1 - \beta}$ | (D) $\beta = \frac{\alpha}{1 + \alpha}$ |
|--|--|--|---|

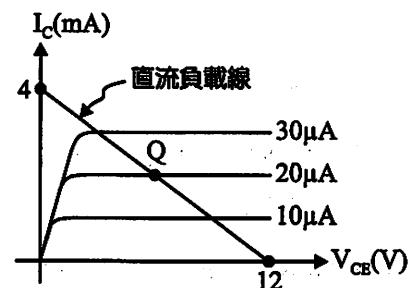
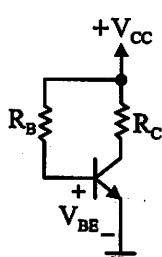
11. 有關電晶體電路之敘述，下列何者正確？

- (A) 達靈頓電晶體電路具有高電流增益與高輸出阻抗
- (B) 共基極(CB)組態電路之輸入/輸出信號反相
- (C) 共射極(CE)組態電路作開關(OFF)使用時， $V_0 \approx V_{CE(sat)} = 0.2\text{ V}$
- (D) NPN 型電晶體頻率響應優於 PNP 型電晶體

12. 如圖(七)所示為電晶體電路與輸出特性曲線。若  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，試求電阻  $R_B$ 、 $R_C$  分

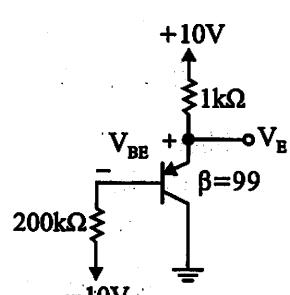
- 別為何？
- (A)  $265\text{ k}\Omega$ 、 $3\text{ k}\Omega$
  - (B)  $5\text{ k}\Omega$ 、 $565\text{ k}\Omega$
  - (C)  $565\text{ k}\Omega$ 、 $3\text{ k}\Omega$
  - (D)  $3\text{ k}\Omega$ 、 $265\text{ k}\Omega$

圖(七)



13. 如圖(八)所示之電晶體電路。若  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，試求電壓  $V_E$  約為何？

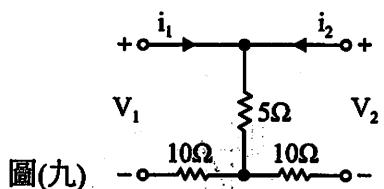
- (A)  $3.6\text{ V}$
- (B)  $4.5\text{ V}$
- (C)  $5.6\text{ V}$
- (D)  $6.5\text{ V}$



圖(八)

14. 如圖(九)所示之電路，當  $i_1 = 0\text{ A}$  時，試求  $\frac{i_2}{V_2} = ?$

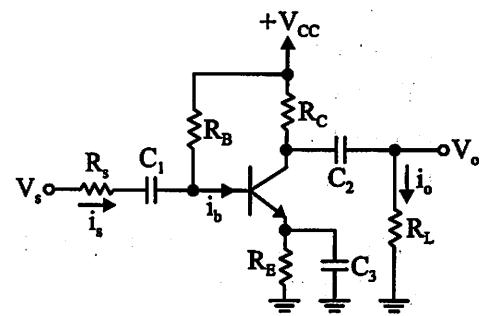
- (A)  $15\text{ }\Omega$
- (B)  $\frac{1}{15}\text{ }\Omega$
- (C)  $\frac{1}{5}\text{ }\Omega$
- (D)  $5\text{ }\Omega$



15. 如圖(十)所示之電晶體電路，若電流增益  $A_{is} = \left| \frac{i_o}{i_s} \right| = \beta \times \frac{R_B}{R_C + R_L} \times A$ ，

試問式中之 A 應為何？

- (A)  $\frac{R_C}{r_n + R_B}$
- (B)  $\frac{R_L}{r_n + R_B}$
- (C)  $\frac{r_n + R_B}{R_C}$
- (D)  $\frac{R_C}{r_n \cdot R_L}$

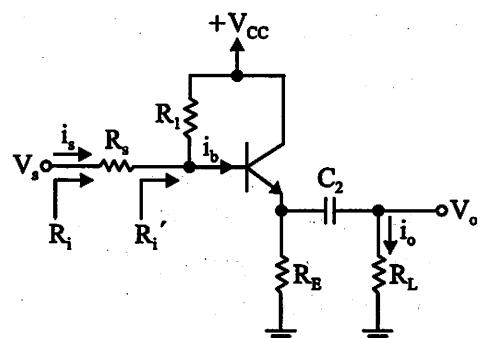


圖(十)

16. 如圖(十一)所示之電晶體電路，若  $R_s = 2.5 \text{ k}\Omega$ 、

$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $R_B = 6 \text{ k}\Omega$ 、 $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 、 $r_n = 1 \text{ k}\Omega$ 、  
 $\beta = 99$ ，試求輸入阻抗  $R_i$  近似為何？

- (A)  $102.5 \text{ k}\Omega$
- (B)  $85 \text{ k}\Omega$
- (C)  $69 \text{ k}\Omega$
- (D)  $58 \text{ k}\Omega$



圖(十一)

17. 承上題，試求電流增益  $A_{is} = \frac{i_o}{i_s}$  近似為何？

- (A) 17
- (B) 22
- (C) 33
- (D) 42

18. 某功率放大器負載為  $50 \Omega$ ，輸出為  $-10 \text{ dBm}$ ，試求此功率放大器之輸出電壓有效值應為何？

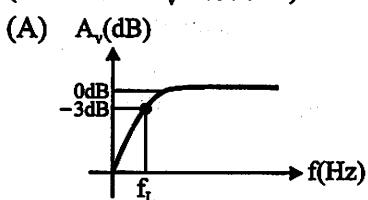
- (A)  $70.7 \text{ mV}$
- (B)  $7.07 \text{ mV}$
- (C)  $141.4 \text{ mV}$
- (D)  $14.14 \text{ mV}$

19. 有關各類串級放大器之敘述，下列何者錯誤？

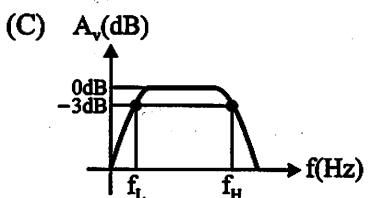
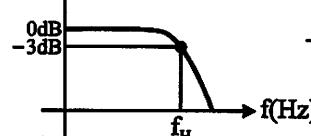
- (A) 直接耦合串級放大器前、後級工作點相互影響，穩定性較差
- (B) 變壓器交連放大器受到線圈電抗影響頻率響應差
- (C) RC 耦合串級放大器為減少低頻訊號衰減，通常會降低交連電容值
- (D) 疊接放大器之設計解決了高頻響應不佳與負載效應的問題

20. 如圖(十二)所示為一被動式濾波電路，下列何者為其頻率響應圖？

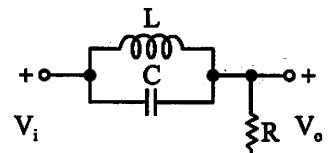
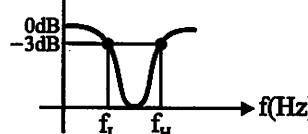
(電壓增益  $A_v$  - 頻率  $f$ )



(B)  $A_v(\text{dB})$



(D)  $A_v(\text{dB})$



圖(十二)

21. 有關場效電晶體(FET)優缺點之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 热稳定性佳，不會像 BJT 有热逃脱現象
- (B) 極高之輸入阻抗，約為  $100\text{ M}\Omega$  以上
- (C) 無抵補(offset)電壓存在，適於作訊號濾波器
- (D) 製造簡易、體積小、適合超大型積體電路(VLSI)，但易受光、熱與磁等輻射影響

22. 如圖(十三)所示為 JFET 電路與其特性轉移曲線。

若  $R_G = 10\text{ M}\Omega$ 、 $R_D = 3\text{ k}\Omega$ 、 $R_s = 2\text{ k}\Omega$ ，則下列

敘述何者錯誤？

- (A)  $P_Q = 4\text{ mW}$
- (B)  $V_{GD} = -7\text{ V}$
- (C)  $V_{GS} = -2\text{ V}$
- (D)  $I_D = 1\text{ mA}$

23. 某一增強型 MOSFET 電路，當  $V_{GS} = 2\text{ V}$  時， $I_D = 1.5\text{ mA}$ ；若提高  $V_{GS} = 3\text{ V}$  時， $I_D = 6\text{ mA}$ 。求臨界電壓  $V_T$  與 K 值分別為何？

- (A)  $V_T = 1.5\text{ V}$ ， $K = 1\text{ mA/V}^2$
- (B)  $V_T = 1\text{ V}$ ， $K = 2.5\text{ mA/V}^2$
- (C)  $V_T = 1\text{ V}$ ， $K = 1.5\text{ mA/V}^2$
- (D)  $V_T = 1.5\text{ V}$ ， $K = 1.5\text{ mA/V}^2$

24. 如圖(十四)所示之電路，若  $R_G = 10\text{ M}\Omega$ 、 $R_D = 7\text{ k}\Omega$ 、 $R_s = 3\text{ k}\Omega$ ，

夾止電壓  $V_P = -4\text{ V}$ ， $I_{DSS} = 16\text{ mA}$ ，求互導  $g_m$  = ?

- (A)  $1\text{ mA/V}$
- (B)  $2\text{ mA/V}$
- (C)  $3\text{ mA/V}$
- (D)  $5\text{ mA/V}$

25. 承上題，電壓增益  $A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$

- (A) -6
- (B) -5
- (C) -3.5
- (D) -2

## 第二部分：基本電學

26. 某家庭設備每週平均使用情形：電鍋  $1200\text{ W}$ (20 小時)，電冰箱  $550\text{ W}$ (120 小時)，電視機  $350\text{ W}$ (40 小時)，電燈合計  $500\text{ W}$ (50 小時)。若電費帳單兩個月為一期，每個月以四週計，電費 3 元/度，且每月用電大於 500 度，每度電加收 20%，小於 500 度，每度電減收 20%，則該家庭用電每期電費約為多少？

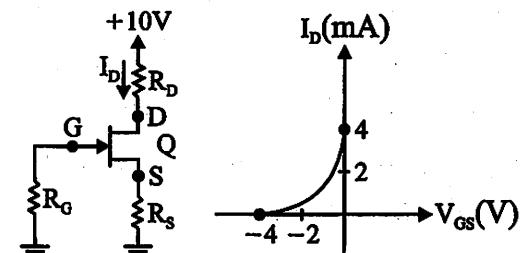
- (A) 1858 元
- (B) 2478 元
- (C) 3096 元
- (D) 3715 元

27. 某電力系統由多個子系統串接而成，其總輸入功率與損失分別為  $250\text{ W}$  與  $160\text{ W}$ 。若子系統之效率分別為： $\eta_甲 = 90\%$ ， $\eta_乙 = 80\%$ ， $\eta_丙 = 60\%$ ， $\eta_丁 = 50\%$ 。試問為符合此電力系統，應如何設計？

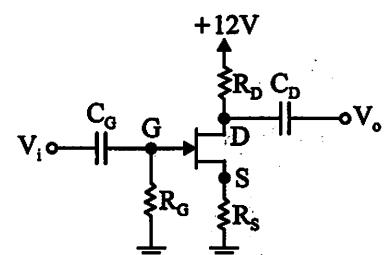
- (A) 甲、乙串接
- (B) 甲、乙、丙串接
- (C) 甲、乙、丁串接
- (D) 乙、丙、丁串接

28. 某  $50\Omega$  導線，使其均勻拉長三倍後，再折成三等分相互並聯，則導線總電阻值變為多少？

- (A)  $50\Omega$
- (B)  $150\Omega$
- (C)  $300\Omega$
- (D)  $450\Omega$



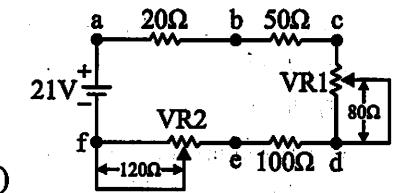
圖(十三)



圖(十四)

29. 如圖(十五)所示之電路，若  $VR_1 = 150\Omega$ 、 $VR_2 = 300\Omega$ ，求電壓  $V_{ce} = ?$

- (A) 6.5 V
- (B) 8.5 V
- (C) 9 V
- (D) 12.5 V



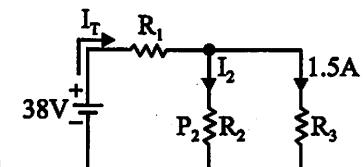
圖(十五)

30. 某串並聯電路之總電阻  $R_T = R_1 + (R_2 // (R_3 + R_4))$  接於 24 V 電源，若  $R_1 = 2\Omega$ 、 $R_2 = 18\Omega$ 、 $R_3 = 3\Omega$ 、 $R_4 = 6\Omega$ ，則求流過電阻  $R_4$  之電流為何？

- (A) 6 A
- (B) 4 A
- (C) 3 A
- (D) 2 A

31. 如圖(十六)所示之串並聯電路，已知  $R_1 : R_2 : R_3 = 1 : 3 : 4$ ，求電阻  $R_2$  之功率  $P_2 = ?$

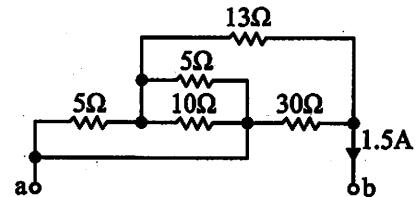
- (A) 48 W
- (B) 40 W
- (C) 36 W
- (D) 25 W



圖(十六)

32. 如圖(十七)所示之電路，求  $V_{ab} = ?$

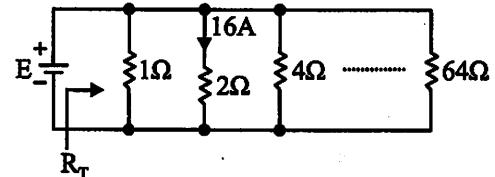
- (A) 5 V
- (B) 10 V
- (C) 15 V
- (D) 20 V



圖(十七)

33. 如圖(十八)所示之電路，求總電阻  $R_T = ?$

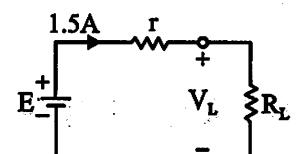
- (A)  $\frac{16}{31}\Omega$
- (B)  $\frac{32}{63}\Omega$
- (C)  $\frac{64}{127}\Omega$
- (D)  $\frac{128}{255}\Omega$



圖(十八)

34. 如圖(十九)所示為一電源供應器電路，其電壓調整率為 25%，當外加負載  $R_L = 8\Omega$  時，則電源供應器內阻  $r = ?$

- (A) 1 Ω
- (B) 2 Ω
- (C) 3 Ω
- (D) 4 Ω



圖(十九)

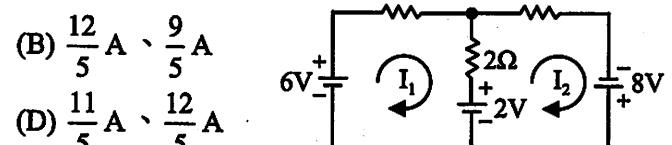
35. 如圖(二十)所示之電路，求電流  $I = ?$

- (A)  $\frac{1}{3}A$
- (B)  $\frac{2}{3}A$
- (C) 1 A
- (D)  $\frac{4}{3}A$

圖(二十)

36. 如圖(二十一)所示之電路，求電流  $I_1$  與  $I_2$  分別為何？

- (A)  $\frac{11}{5}A$ 、 $\frac{9}{5}A$
- (B)  $\frac{12}{5}A$ 、 $\frac{9}{5}A$
- (C)  $\frac{9}{5}A$ 、 $\frac{12}{5}A$
- (D)  $\frac{11}{5}A$ 、 $\frac{12}{5}A$

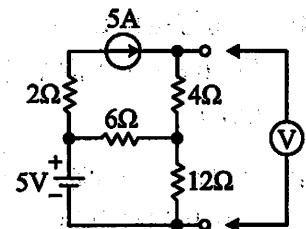


圖(二十一)

37. 如圖(二十二)所示之電路，(V)為理想電壓表，若只單獨考慮電流

源 5 A 效應，求電壓表所量測之值為何？

- (A) 50 V
- (B) 40 V
- (C) 20 V
- (D) 10 V

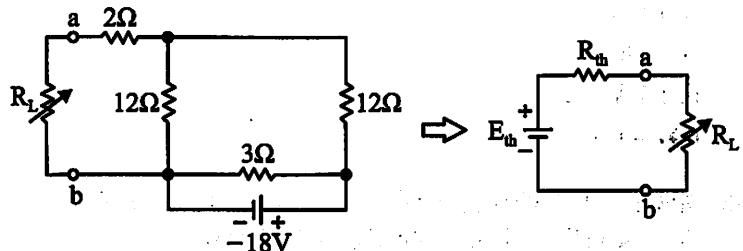


圖(二十二)

38. 如圖(二十三)所示為負載  $R_L$  之戴維寧等效

電路。求戴維寧等效電壓  $E_{th} = ?$

- (A) 15 V
- (B) 12 V
- (C) 10 V
- (D) 9 V



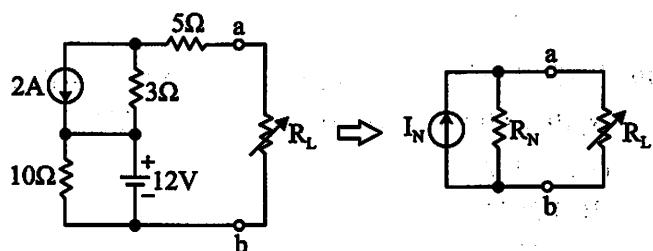
圖(二十三)

39. 承上題，若  $R_L = 1\Omega$  時，求其功率為何？

- (A) 1 W
- (B) 2 W
- (C) 3 W
- (D) 4 W

40. 如圖(二十四)所示為負載  $R_L$  之諾頓等效電路。求負載  $R_L$  之諾頓等效電流  $I_N = ?$

- (A)  $\frac{9}{4}$  A
- (B)  $\frac{3}{4}$  A
- (C)  $\frac{3}{2}$  A
- (D)  $\frac{9}{2}$  A



圖(二十四)

41. 承上題，求負載  $R_L$  可獲得最大功率為何？

- (A)  $\frac{9}{2}$  W
- (B)  $\frac{9}{4}$  W
- (C)  $\frac{9}{8}$  W
- (D)  $\frac{9}{16}$  W

42. 在空氣中有一正電荷  $Q = 4 \times 10^{-6} C$ ，求距離該電荷 0.3 m 處之電通密度  $D$  為何？

- (A)  $3.54 \times 10^{-6} C/m^2$
- (B)  $3.54 \times 10^{-7} C/m^2$
- (C)  $7.08 \times 10^{-6} C/m^2$
- (D)  $7.08 \times 10^{-7} C/m^2$

43. 某平行板電容器之電容量  $C = 32 \mu F$ ，若將其極板之邊長減半，極板間距加倍，其餘不變情形下，則電容值變為多少？

- (A) 4  $\mu F$
- (B) 16  $\mu F$
- (C) 64  $\mu F$
- (D) 128  $\mu F$

44. 三個電容器  $C_1 = 5 \mu F$ 、 $C_2 = 10 \mu F$ 、 $C_3 = 5 \mu F$ ，現將其串聯接於 100 V 電源，求  $C_2$  所儲存之電能為何？

- (A) 8 mJ
- (B) 4 mJ
- (C) 2 mJ
- (D) 1 mJ

45. 三個電感串聯電路，通以 2 A 電流，產生 300 mJ 儲能。若不考慮互感值，且電感值比分別為  $L_1 : L_2 : L_3 = 1 : 2 : 3$ ，求  $L_2 = ?$

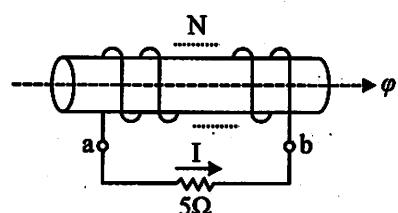
- (A) 25 mH
- (B) 50 mH
- (C) 75 mH
- (D) 100 mH

46. 某電感電路  $L_1 : L_2 = 1 : 4$ ，若將其接成串聯互助時，總電感量為  $60 \text{ mH}$ ，改接成串聯互消時，總電感量為  $10 \text{ mH}$ ，求兩電感之耦合係數  $K$  最接近何值？

- (A) 0.3      (B) 0.5      (C) 0.7      (D) 0.9

47. 如圖(二十五)所示，假設線圈  $N = 100$  匝，當線圈內之磁通  $\phi$  在  $0.2$  秒內從  $0.12$  韋伯變為  $0.04$  韋伯時，求流經電阻  $5\Omega$  之電流  $I = ?$

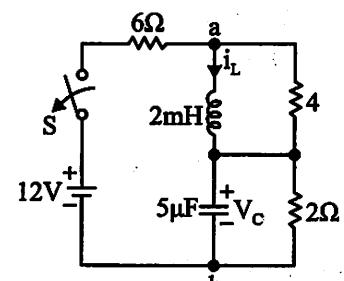
- (A)  $8 \text{ A}$   
 (B)  $-8 \text{ A}$   
 (C)  $4 \text{ A}$   
 (D)  $-4 \text{ A}$



圖(二十五)

48. 如圖(二十六)所示之穩定電路( $S$  閉合很久)，若在  $t=0$  秒瞬間將開關  $S$  打開，求  $S$  打開瞬間電容電壓  $V_c = ?$

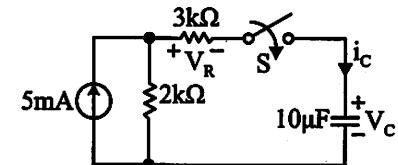
- (A)  $9 \text{ V}$   
 (B)  $7 \text{ V}$   
 (C)  $5 \text{ V}$   
 (D)  $3 \text{ V}$



圖(二十六)

49. 如圖(二十七)所示之電路，在  $t=0$  秒時，開關  $S$  閉合(假設  $V_c(0^-) = 0 \text{ V}$ )，求  $t=0.1$  秒時，電阻電壓  $V_R$  約為何？

- (A)  $0.81 \text{ V}$   
 (B)  $1.35 \text{ V}$   
 (C)  $6.32 \text{ V}$   
 (D)  $8.65 \text{ V}$

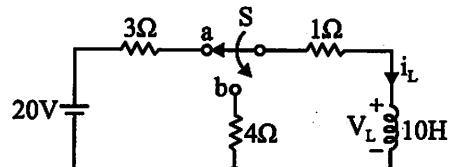


圖(二十七)

50. 如圖(二十八)所示之電路，開關  $S$  切至位置  $a$  達穩態，於  $t=0$  秒時，將開關  $S$  切換至位置  $b$ ，求需經過多久時間，電感電流  $i_L = 0.25 \text{ A}$ ？

- (A) 2 秒  
 (B) 4 秒  
 (C) 6 秒  
 (D) 7.5 秒

圖(二十八)



【以下空白】

# 105 學年度四技二專第二次聯合模擬考試

## 電機與電子群 專業科目(一) 詳解

105-2-03-4、105-2-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	B	D	A	B	D	A	C	D	B	D	C	A	B	A	C	B	A	C	D	D	A	C	B	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	C	A	B	D	A	C	C	B	A	D	B	D	A	B	C	A	A	C	B	D	B	D	A	C

**第一部分：電子學**

1.  $V_{av} = \frac{t_{ON} \times V_m}{T} \Rightarrow 12 = 75\% \times V_m \Rightarrow V_m = 16V$
- $$\therefore V_{eff} = \sqrt{\frac{V_m^2 \times t_{ON}}{T}} = \sqrt{16^2 \times \frac{3}{4}} = 8\sqrt{3}V$$
2. (B) 鎢(Ge)元素耐溫度較低
3. (A) 雜質濃度愈高，電阻愈低，耐壓愈低  
 (B) 環境溫度愈高，導電性提高  
 (C) 在 N 型半導體中，電洞濃度隨溫度升高而減少
- 4.
- 
- $$15 \times \frac{30}{30+60} = 5V$$
- $$\therefore (30//60) + R = \frac{5-1.6}{17m} = 200$$
- $$\therefore R = 180\Omega$$
5. 假設 D ON
- $$V_o = \frac{\frac{5-0.7}{2} + \frac{5}{1} + \frac{(-1)}{1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = 2.46V \approx 2.5V$$
6.  $V_{o(de)} = \frac{2}{\pi} V_m' \Rightarrow 20 = \frac{2}{\pi} \cdot V_m'$
- $$\therefore V_m' = 10\pi \Rightarrow V_{2m} = 2 \times V_m' = 20\pi$$
- $$\therefore V_{im} = \frac{5}{1} \times V_{2m} = 100\pi = 314V$$
- $$\therefore V_{i(t)} = 314 \sin \omega t$$
7. PIV =  $V_m = 10\sqrt{2}V$
- $$\therefore V_{o(de)} = \frac{2}{\pi} V_m = \frac{20\sqrt{2}}{\pi} \approx 9V$$
8.  $12V \times \frac{6}{6+3} = 8V$
- $\therefore D_1$  off,  $D_2$  ON
- $$\therefore V_x = 0.6 + (-5) = -4.4V$$
9. CB 具有最高電壓增益  
 CE 具有最高功率增益
10. (A)  $\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha} - 1$

$$(C) \alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$

$$(D) \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

11. (A) 達靈頓電晶體電路具有高電流增益與低輸出阻抗  
 (B) 共基極(CB)組態電路之輸入/輸出信號同相位  
 (C) 共射極(CE)組態電路作開關(OFF)使用時  
 $I_B = 0A, I_C = I_E \neq 0A$
12. 負載方程式  $= V_{cc} = I_c \cdot R_c + V_{ce}$   
 $I_c = 0 \Rightarrow V_{ce} = V_{cc} = 12V$
- $$V_{ce} = 0 \Rightarrow I_c = \frac{V_{cc}}{R_c} = 4mA$$
- $$\therefore R_c = \frac{12}{4} = 3k\Omega, I_B = \frac{V_{ce}-0.7}{R_B}$$
- $$\Rightarrow 20\mu A = \frac{12-0.7}{R_B} \Rightarrow R_B = 565k\Omega$$
13.  $10 - (-10) - 0.7 = 1 \times I_B + 200I_B = 300I_B$
- $$\therefore I_B = \frac{20-0.7}{300} \approx 0.064mA$$
- $$\therefore I_E = (1+99) \times I_B = 6.4mA$$
- $$\therefore V_E = 10 - 6.4 \times 1 = 3.6V$$
14.  $\frac{i_2}{v_2} = \frac{1}{(5+10)} = \frac{1}{15}\Omega$
15. (A)  $i_o = -\beta i_b \times \frac{R_c}{R_c + R_L}$  其中  $i_b = i_s \times \frac{R_B}{R_B + r_n}$  (代入  $i_o$  中)
- $$\therefore i_o = -\beta \times (i_s \times \frac{R_B}{R_B + r_n}) \times \frac{R_c}{R_c + R_L}$$
- $$\therefore A_{IS} = \left| \frac{i_o}{i_s} \right| = \beta \times \frac{R_B}{R_B + r_n} \times \frac{R_c}{R_c + R_L}$$
16.  $R_i' = R_1 // [r_n + (1+\beta)(R_B // R_L)]$
- $$R_i = R_s + R_i' = 2.5 + 100 // [1 + 100 \times (6//3)]$$
- $$= 2.5 + (100 // 201) \approx 69k\Omega$$
17.  $\frac{i_o}{i_s} = \frac{i_o}{i_b} \times \frac{i_b}{i_s}$
- $$= (1+\beta) \times \frac{R_B}{R_B + R_L} \times \frac{R_c}{R_1 + [r_n + (1+\beta)(R_B // R_L)]}$$

$$= 100 \times \frac{6}{6+3} \times \frac{100}{100 + [1+100 \times (6//3)]} = \frac{200}{9} = 22$$

18.  $-10 = 10 \cdot \log\left(\frac{P_o}{1 \text{mW}}\right)$

$$\therefore \frac{P_o}{1 \text{mW}} = 10^{-1} \Rightarrow P_o = 0.1 \text{mW}$$

$$\therefore V_{o(\text{rms})} = \sqrt{P_o \times 50} = 5\sqrt{2} \times 10^{-2} \text{V} = 70.7 \text{mV}$$

19. (C) RC 耦合串級放大器為減少低頻訊號衰減，通常提高交連電容值

20. (A) 高通濾波器  
(B) 低通濾波器  
(C) 帶通濾波器

21. (D) 製造簡易、體積小、適合超大型積體電路(VLSI)，且不易受光、熱與磁等輻射影響

22. 如圖， $I_{DSS} = 4 \text{mA}$ ， $V_p = -4 \text{V}$  且  $V_{GS} = -2I_D$

$$\therefore I_D = 4 \times \left(1 - \frac{-2I_D}{4}\right)^2 = 4 \times \left(1 - \frac{1}{2}I_D\right)^2$$

$$\Rightarrow I_D^2 - 5I_D + 4 = 0, I_D = 1 \text{mA} \text{ 或 } 4 \text{mA} (\text{不合})$$

$$\therefore V_{GS} = -2 \times 1 = -2 \text{V}$$

$$\therefore V_{DS} = 10 - 1 \times (3 + 2) = 5 \text{V}$$

$$\therefore V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = -2 - 5 = -7 \text{V} < V_p (\text{飽和區})$$

$$P_Q = I_D \times V_{DS} = 1 \text{mA} \times 5 = 5 \text{mW}$$

23.  $\begin{cases} 1.5 = K(2 - V_T)^2 \\ 6 = K(3 - V_T)^2 \end{cases} \Rightarrow V_T = 1 \text{V}, K = 1.5 \text{mA/V}^2$

24. ①  $V_{GS} = -3I_D$ ， $I_D = 16 \times \left(1 - \frac{-3I_D}{4}\right)^2 = 16 \times \left(1 - \frac{3}{4}I_D\right)^2$

$$9I_D^2 - 25I_D + 16 = 0, \therefore I_D = 1 \text{mA} \text{ 或 } \frac{16}{9} \text{mA} (\text{不合})$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -3 \times 1 = -3 \text{V}$$

$$\begin{aligned} \text{② } g_m &= \frac{2I_{DSS}}{-V_p} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = \frac{2 \times 16}{4} \times \left(1 - \frac{-3}{4}\right) = 8 \times \frac{1}{4} \\ &= 2 \text{mA/V} \end{aligned}$$

25.  $A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{-g_m \cdot R_D}{1 + g_m R_S} = -\frac{2 \times 7}{1 + 2 \times 3} = -2$

## 第二部分：基本電學

26.  $W_{度(月)} = (1.2 \times 20 + 0.55 \times 120 + 0.35 \times 40 + 0.5 \times 50) \times 4 = 516 \text{ 度/月} (> 500 \text{度})$

$$\$_{(月)} = (516 \times 1.2 \times 3) \times 2 = 3715 \text{ 元}$$

27.  $\eta_T = \frac{P_o}{P_i} = \frac{P_i - P_{loss}}{P_i} = \left(1 - \frac{P_{loss}}{P_i}\right) = \left(1 - \frac{160}{250}\right) = 0.36 = 36\% (\text{總效率})$

故甲、乙、丁串接效率 =  $0.9 \times 0.8 \times 0.5 = 0.36$

28. ① 拉長 3 倍後  $R' = 3^2 \times 50 \Omega = 450 \Omega$

② 折半並聯後  $R'' = \frac{450}{3} \times \frac{1}{3} = 50 \Omega$

29.  $V_{ce} = 21 \times \frac{(150 - 80) + 100}{20 + 50 + (150 - 80) + 100 + (300 - 120)}$

$$= 21 \times \frac{170}{420} = 8.5 \text{V}$$

30.  $I_{R4} = \frac{24 \text{V}}{2 + (18 // (3+6))} \times \frac{18}{18 + (3+6)} = 3 \times \frac{18}{27} = 2 \text{A}$

31. 令  $R_1 = x, R_2 = 3x, R_3 = 4x$

$$\therefore I_2 = \frac{1.5 \times 4x}{3x} = 2 \text{A}$$

$$\therefore I_T = 2 + 1.5 = 3.5 \text{A}$$

$$\therefore 38 \text{V} = 3.5x + 2 \times 3x = 9.5x \Rightarrow x = 4$$

$$\therefore P_{R_2} = I_2^2 \times R_2 = 2^2 \times (3 \times 4) = 48 \text{W}$$

32.  $V_{ab} = 1.5 \times (5 // 5 // 10 + 13) // 30 = 1.5 \times (15 // 30) = 1.5 \times 10 = 15 \text{V}$

33.  $E = 16 \times 2 = 32 \text{V}$

$$I_T = \frac{32}{1} + \frac{32}{2} + \frac{32}{4} + \dots + \frac{32}{64} = 32 + 16 + 8 + \dots + 1 + \frac{1}{2} = 63.5 \text{A}$$

$$\therefore R_T = \frac{E}{I_T} = \frac{32}{63.5} = \frac{64}{127} \Omega$$

34.  $\frac{E - V_L}{V_L} = \frac{1}{4} \Rightarrow E = \frac{5}{4}V_L, V_L = 1.5 \times 8 = 12 \text{V}$

$$\therefore E = \frac{5}{4} \times 12 = 15 \text{V}, \therefore 15 - 12 = 1.5 \times r, \therefore r = 2 \Omega$$

35.  $\frac{V_o + 9}{6} + \frac{V_o}{2} + \frac{V_o - 24}{12} = 0$

$$\Rightarrow 2V_o + 18 + 6V_o + V_o - 24 = 0$$

$$9V_o = 6 \Rightarrow V_o = \frac{2}{3} \text{V}$$

$$\therefore I = \frac{V_o}{2} = \frac{1}{3} \text{A}$$

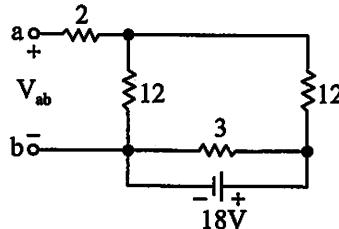
36.  $\begin{cases} 6 - 2 = (2 + 2)I_1 - 2I_2 \\ 8 + 2 = -2I_1 + (4 + 2)I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 2I_1 - I_2 \dots \dots \textcircled{1} \\ 10 = -2I_1 + 6I_2 \dots \dots \textcircled{2} \end{cases}$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \Rightarrow 12 = 5I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{12}{5} \text{A}, \therefore I_1 = \frac{11}{5} \text{A}$$

37. 考慮 5 A(令 5 V 短路)

$$\therefore (V) = 5 \times (4 + (6 // 12)) = 5 \times (4 + 4) = 40 \text{V}$$

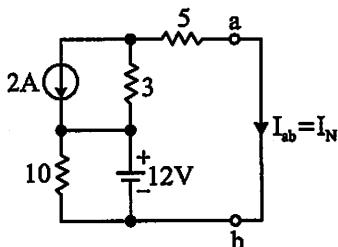
38. 求  $V_{th} = V_{ab} = 18 \text{V} \times \frac{12}{12 + 12} = 9 \text{V}$



39. 求  $R_{th} = R_{ab}$  (令 18V → 短路) =  $2 + 12 // 12 = 8 \Omega$

$$\therefore P_{R_L} = \left(\frac{9}{8+1}\right)^2 \times 1 = 1 \text{W}$$

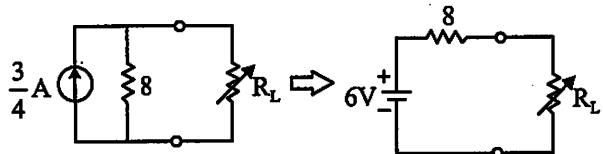
40.  $I_N = I_{ab} = (-2) \times \frac{3}{(3+5)} + \frac{12}{(3+5)} = -\frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \text{A}$



$$41. R_N = R_{ab} = 3 + 5 = 8 \Omega$$

$$\Rightarrow E_{th} = I_N \times R_N = \frac{3}{4} \times 8 = 6 \text{ V}$$

$$\therefore P_{R_L(\max)} |_{R_L=8} = \frac{E_{th}^2}{4 \times R_{th}} = \frac{6^2}{4 \times 8} = \frac{36}{32} = \frac{9}{8} \text{ W}$$



$$42. \text{電場強度 } E = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6}}{(0.3)^2} = 4 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$\begin{aligned} \text{電通密度 } D &= \epsilon_0 \times E = 8.85 \times 10^{-12} \times (4 \times 10^5) \\ &= 35.4 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2 = 3.54 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2 \end{aligned}$$

$$43. C = \epsilon \times \frac{A}{d}$$

$$C_o = \epsilon \times \frac{A_o}{d_o} = \epsilon \times \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot A}{2d} = \frac{1}{8} \times (\epsilon \cdot \frac{A}{d}) = \frac{1}{8} C$$

$$= \frac{1}{8} \times 32 \mu\text{F} = 4 \mu\text{F}$$

$$44. C_T = 5 // 10 // 5 = 2 \mu\text{F}$$

$$Q_T = C_T \times E = 2\mu \times 100 = 200 \mu\text{C}$$

$$W_{C_2} = \frac{Q_T^2}{2C_2} = \frac{(200\mu)^2}{2 \times 10\mu} = 2 \text{ mJ}$$

$$45. \text{令 } L_1 = x \text{ 、 } L_2 = 2x \text{ 、 } L_3 = 3x$$

$$W = \frac{1}{2} L_T \times I^2 \Rightarrow 300 \text{ m} = \frac{1}{2} \times (x + 2x + 3x) \times 2^2$$

$$\Rightarrow x = \frac{300 \text{ m}}{2 \times 6} = 25 \text{ m}$$

$$\therefore L_2 = 2 \times 25 \text{ m} = 50 \text{ mH}$$

$$46. \begin{cases} L_1 + L_2 + 2M = 60 \text{ mH} \\ L_1 + L_2 - 2M = 10 \text{ mH} \end{cases}$$

$$\Rightarrow M = 12.5 \text{ mH} \text{, 又 } L_2 = 4L_1$$

$$\therefore L_1 + 4L_1 = 60 \text{ mH} - (2 \times 12.5 \text{ mH})$$

$$\Rightarrow 5L_1 = 35 \text{ mH} \Rightarrow L_1 = 7 \text{ mH}, L_2 = 28 \text{ mH}$$

$$\Rightarrow 12.5 = k \times \sqrt{7 \times 28} \Rightarrow k = \frac{12.5}{14} \approx 0.9$$

$$47. e_{ab} = N \cdot \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = 100 \times \frac{(0.04 - 0.12)}{0.2} = -40 \text{ V}$$

$$\therefore I = \frac{-40}{5} = -8 \text{ A}$$

48. 穩態  $\Rightarrow L$  短路,  $C$  開路

S 打開瞬間  $V_c$  :

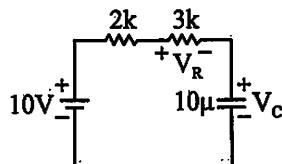
$$V_{c(o')} = 12 \times \frac{2}{6+2} = 3 \text{ V}$$

$$49. ① \tau = R \cdot C = (3k + 2k) \times 10\mu = 50 \text{ ms}$$

$$② t = 0.1 \text{ s} = 2\tau$$

$$\therefore V_{c(0.1s)} = 10 \cdot (1 - e^{-2}) = 10 \times (1 - 0.135) = 8.65 \text{ V}$$

$$\therefore V_R = (10 - 8.65) \times \frac{3}{2+3} = 0.81 \text{ V}$$



$$50. ① s \rightarrow a, i_L = \frac{20}{3+1} = 5 \text{ A}$$

$$② s \rightarrow b, \tau = \frac{10}{4+1} = 2 \text{ 秒}, i_L = 5 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$③ i_{L(0)} = 0.25 \text{ A} = 5 \times e^{\frac{0}{\tau}}$$

$$\therefore t = 3\tau = 3 \times 2 = 6 \text{ 秒}$$

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

105-2-04-5

105 學年度科技校院四年制與專科學校二年制  
統一入學測驗第二次聯合模擬考試題本

**電機與電子群資電類**

**專業科目(二)：數位邏輯、  
數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論**

**【注意事項】**

1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷分四部份，共 50 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。  
第一部份(第 1 至 12 題，每題 2 分，共 24 分)  
第二部份(第 13 至 25 題，每題 2 分，共 26 分)  
第三部份(第 26 至 37 題，每題 2 分，共 24 分)  
第四部份(第 38 至 50 題，每題 2 分，共 26 分)
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有(A)、(B)、(C)、(D)四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

## 第一部分：數位邏輯

1. 下列說明何者錯誤？

- (A) 將數位信號轉成類比信號的電路稱為 DAC
- (B) 正弦波電壓波形是屬於數位信號
- (C) 數位信號只有兩種狀態，不是 0 就是 1
- (D) 指針式的三用電錶不是屬於數位表示法

2. 在電腦系統中數目的減法運算是以下列何者方式來做運算？

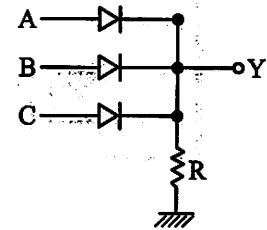
- (A) 9 的補數
- (B) 10 的補數
- (C) 16 的補數
- (D) 2 的補數

3. 假設今年某校招收 1000 名學生，試問至少需要多少位元才能將該學生的學號加以編號？

- (A) 1000 位元
- (B) 11 位元
- (C) 10 位元
- (D) 9 位元

4. 如圖(一)所示之電路，若以負邏輯來考慮，應為何種邏輯閘？

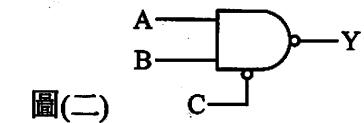
- (A) AND
- (B) OR
- (C) NAND
- (D) NOR



圖(一)

5. 如圖(二)所示為三態邏輯閘，其中 C 為控制信號，則下列敘述何者正確？

- (A)  $C=1, Y=\overline{AB}$
- (B)  $C=0, Y=\overline{A}+\overline{B}$
- (C)  $C=0, Y=A+B$
- (D)  $C=1, Y=ABC$



圖(二)

6. 化簡  $\overline{\overline{ABC}} + \overline{ABC} = ?$

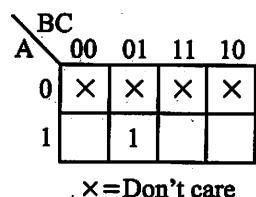
- (A)  $\overline{BC}$
- (B)  $\overline{B}C$
- (C) 1
- (D)  $\overline{C}$

7. 下列哪一個邏輯閘不符合結合律？

- (A) NAND
- (B) AND
- (C) OR
- (D) XOR

8. 如圖(三)所示之卡諾圖，下列何者為最佳的表示式？

- (A)  $\overline{A}$
- (B)  $\overline{A} + \overline{B}C$
- (C)  $\overline{B}C$
- (D)  $A\overline{B}C$



圖(三)

9. 對於邏輯運算  $F(A, B, C, D, E) = \overline{(A+BC)D+E}$ ，若只有邏輯閘 AND、OR、NOT，且每一種邏輯閘之運算時間延遲均為 3 ns，在不化簡的情形下，輸入 A、B、C、D、E 信號後，需經多少時間輸出 F 才能得到正確的結果？

(A) 9 ns

(B) 12 ns

(C) 15 ns

(D) 18 ns

10. 如圖(四)所示為解碼器 74138 所組成的電路，輸出

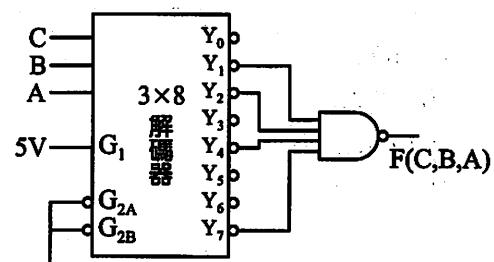
$F(C, B, A)$  為：

(A)  $\pi(0, 3, 5, 6)$

(B)  $\Sigma(0, 3, 5, 6)$

(C)  $\pi(1, 2, 4, 7)$

(D)  $\Sigma(2, 4, 6, 8)$



圖(四)

11. 下列何者無法單獨組合出三個變數的任意布林代數？

#### (A) NAND 閘

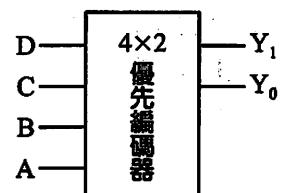
## (B) AND 間

(C) NOR 開

(D) 8 對 1 多工器

12. 如圖(五)所示為一個4對2的優先編碼器，其輸入的優先順序由高至低為D、C、B、A，輸出為 $Y_1$ 、 $Y_0$ ， $Y_1$ 為高位元，求 $Y_1(D, C, B, A)$ 的輸出最簡布林代數為何？

D	C	B	A	$Y_1$	$Y_0$
1	X	X	X	1	1
0	1	X	X	1	0
0	0	1	X	0	1
0	0	0	1	0	0



圖(五)

## 第二部分：數位邏輯實驗



15. 有關使用邏輯探棒的敘述，下列何者正確？

  - (A) 測試時先將邏輯探棒的紅黑線夾接至待測電路的電源端
  - (B) 邏輯探棒內需裝電池
  - (C) 只可測試待測電路的 H 或 L 狀態
  - (D) 可測出 IC 的編號

16. 緩衝邏輯閘在數位電路上的功用為何？

  - (A) 倒相放大
  - (B) 電壓放大
  - (C) 增加扇出能力
  - (D) 耦合電路

17. 對於邏輯族系 TTL 而言， $V_o$ 代表輸出電壓， $V_i$ 為輸入電壓，H 為高態，L 為低態，下列何者正確？
- (A)  $V_{oH} > V_{oL} > V_{iH} > V_{iL}$
  - (B)  $V_{oH} > V_{iH} > V_{iL} > V_{oL}$
  - (C)  $V_{oH} > V_{iH} > V_{oL} > V_{iL}$
  - (D) 視電源電壓的大小而決定

18. 如圖(六)所示，由閘 A 去推動閘 B，求其最大的扇出數為何？

- (A) 60 個
- (B) 20 個
- (C) 12 個
- (D) 10 個

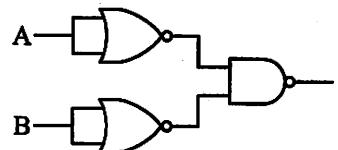


閘 A :	閘 B :
$I_{il}=2.4\text{mA}$	$I_{il}=2\text{mA}$
$I_{ih}=10\mu\text{A}$	$I_{ih}=20\mu\text{A}$
$I_{ol}=24\text{mA}$	$I_{ol}=30\text{mA}$
$I_{oh}=200\mu\text{A}$	$I_{oh}=600\mu\text{A}$

圖(六)

19. 如圖(七)所示之邏輯電路，其功能相當於：

- (A) AND 閘
- (B) NOR 閘
- (C) OR 閘
- (D) NAND 閘



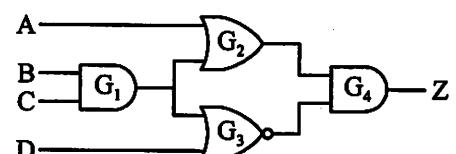
圖(七)

20. 使用二輸入的 NOR 閘來組成四輸入的 NOR 閘，共需幾個輸入的 NOR 閘？

- (A) 5 個
- (B) 6 個
- (C) 7 個
- (D) 8 個

21. 如圖(八)所示之電路，假設  $G_2$  (OR 閘)壞掉而造成其輸出一直為 1，請藉由觀察 Z 的輸出值，試問下列哪一組輸入信號(ABCD)可以偵測到此電路錯誤的狀況？

- (A) 0111
- (B) 1001
- (C) 0011
- (D) 0000



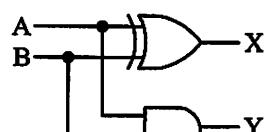
圖(八)  $G_1$  : AND  $G_2$  : OR  $G_3$  : NOR  $G_4$  : AND

22. 半加器使用 AND、OR、NOT 閘來組成，總共至少需要幾個閘？

- (A) 5 個
- (B) 6 個
- (C) 7 個
- (D) 8 個

23. 如圖(九)所示之電路，下列敘述何者錯誤？

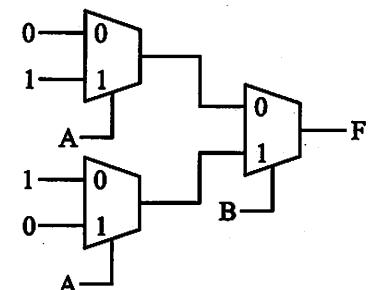
- (A) 為一個半減器電路
- (B) 本電路執行  $A - B$  的運算
- (C) Y 為借位輸出
- (D) 本電路不考慮前一位元的借位



圖(九)

24. 如圖(十)所示由 2 對 1 多工器所組成的電路，其輸出 F 之布林代數為何？

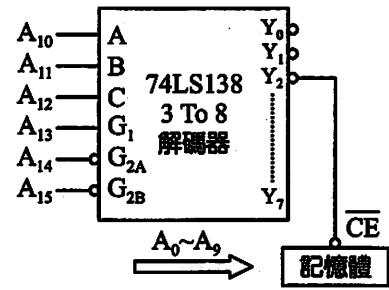
- (A)  $A \oplus B$
- (B)  $A \oplus B$
- (C)  $A + B$
- (D)  $\overline{AB}$



圖(十)

25. 如圖(十一)所示為微電腦系統中記憶體的解碼電路，其中  $G_1$ 、 $G_{2A}$ 、 $G_{2B}$  為致能端，A、B、C 為解碼輸入，C 為高位元，Y 為解碼輸出，此記憶體的位址線有 16 條( $A_0 \sim A_{15}$ )，求此記憶體之位址範圍為何？(以十六進制表示)

- (A) 2400H~27FFH
- (B) C400H~C7FFH
- (C) 2800H~2BFFH
- (D) 1000H~17FFH



圖(十一)

(CE為記憶體授權端)

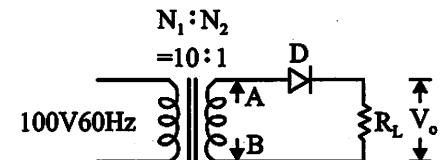
### 第三部分：電子學實習

26. 工廠配線時，電線粗細的選擇主要是依據下列何者來決定？

- |           |          |
|-----------|----------|
| (A) 電壓大小  | (B) 電線長度 |
| (C) 大樓的高度 | (D) 電流大小 |

27. 如圖(十二)所示為半波整流電路，若使用三用電表切至 DCV 檔，量 A、B 兩點的電壓為何？

- (A) 3.18 V
- (B) 4.5 V
- (C) 6.36 V
- (D) 0 V



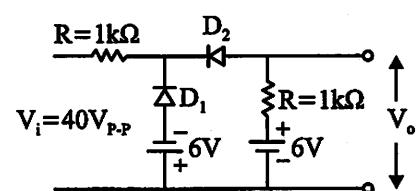
圖(十二)

28. 承上題，若要使用示波器觀測  $V_o$  的波形，且波形需含有直流準位，則示波器需將輸入耦合切在：

- (A) GND 位置
- (B) AC 位置
- (C) DC 位置
- (D) X-Y 模式

29. 如圖(十三)所示之電路， $D_1$ 、 $D_2$  為理想二極體，輸入為  $40V_{P-P}$  的對稱正弦波，則輸出電壓的峰對峰值為何？

- (A)  $6V_{P-P}$
- (B)  $8V_{P-P}$
- (C)  $12V_{P-P}$
- (D)  $16V_{P-P}$



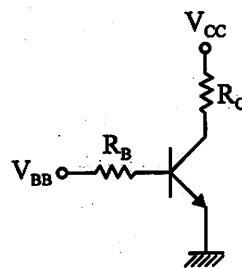
圖(十三)

30. 電晶體在  $I_B \times \beta = I_C$  時，在何種區域時(忽略漏電電流)不一定會成立？

- |         |                     |
|---------|---------------------|
| (A) 飽和區 | (B) 截止區             |
| (C) 作用區 | (D) $V_{CE} >> 0$ V |

31. 如圖(十四)所示之電路，欲使電晶體進入飽和區，下列哪一個方式可行？

- (A)  $R_c$  變小
- (B)  $R_B$  變大
- (C)  $V_{BB}$  變小
- (D) 換 B 極寬度佔電晶體全部寬度比值較小的電晶體



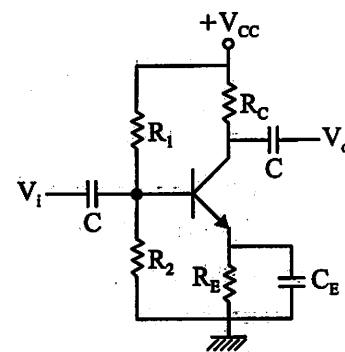
圖(十四)

32. 如圖(十五)所示之電路，若工作點 Q 點靠近電晶體之截止區，則下列敘述何者正確？

- (A)  $A_v < 0$ ，且  $V_o$  負半週易產生失真現象
- (B)  $A_v < 0$ ，且  $V_o$  正半週易產生失真現象
- (C)  $A_v > 0$ ，且  $V_o$  負半週易產生失真現象
- (D)  $A_v > 0$ ，且  $V_o$  正半週易產生失真現象

33. 承上題， $C_E$  的主要功用為何？

- (A) 隔斷直流
- (B) 提高交流電壓增益
- (C) 改善低頻不良
- (D) 提高直流電壓增益



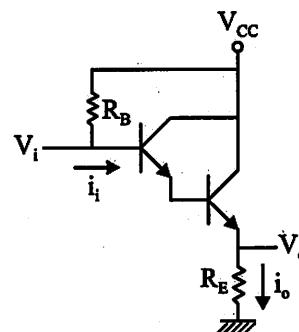
圖(十五)

34. 承上題， $C$  為耦合電容，其最主要的缺點為何？

- (A) 低頻不良
- (B) 高頻不良
- (C) 隔斷直流
- (D) 使  $V_o$  與  $V_i$  相位相反

35. 如圖(十六)所示之電路，下列敘述何者錯誤？

- (A) 電流增益大
- (B) 輸入阻抗高
- (C) 直流偏壓穩定性佳
- (D) 低頻響應佳



圖(十六)

36. 某 N 通道的 JEET 的  $V_p = -2$  V，下列哪一組電壓與工作區的敘述錯誤？

- (A) 若  $V_{DS} = 7$  V， $V_{GS} = -4$  V，則該 JFET 工作於截止區
- (B) 若  $V_{DS} = 0.5$  V， $V_{GS} = -0.5$  V，則該 JFET 工作於歐姆區
- (C) 若  $V_{DS} = 1$  V， $V_{GS} = 0$  V，則該 JFET 工作於飽和區
- (D) 若  $V_{DS} = 3$  V， $V_{GS} = -1$  V，則該 JFET 工作於飽和區

37. 場效應電晶體(FET)被拿來當作放大器的第一級是利用它的什麼優點？

- (A) 電流增益大
- (B) 輸入阻抗大
- (C) 輸出阻抗大
- (D) D、S 極可交換

## 第四部分：計算機概論

38. 每次月考結束後，老師需在一定時間內(如 5 天)將學生的月考成績上傳至校務行政系統，最後再由該系統一次處理全校的月考成績，請問這種資料處理是屬於下列哪一種型態？
- (A) 即時系統
  - (B) 交談式處理
  - (C) 批次處理
  - (D) 分散式處理
39. 下列何者不屬於自動化 3A 的範圍？
- (A) 企業自動化
  - (B) 家庭自動化
  - (C) 工廠自動化
  - (D) 辦公室自動化
40. 有關 GPS(全球定位系統)收費方式的敘述，下列何者正確？
- (A) GPS 是一種免費服務
  - (B) GPS 是計次收費
  - (C) GPS 是按照距離收費
  - (D) GPS 是計時收費
41. 下列哪一個裝置通常不被視為輸出裝置？
- |         |         |
|---------|---------|
| (A) 顯示器 | (B) 印表機 |
| (C) 喇叭  | (D) 滑鼠  |
42. 快取記憶體(Cache Memory)具有存取速度快、減少 CPU 對記憶體存取次數、增加電腦執行速度的特性，通常其組成的元件為下列何者？
- |                  |          |
|------------------|----------|
| (A) DRAM         | (B) SRAM |
| (C) Flash Memory | (D) 硬碟   |
43. 某程式在記憶體內的位址範圍由  $AC20_{(16)}$  到  $BC1F_{(16)}$ ，試問該程式所佔的記憶體空間大小為多少個位元組？
- |          |          |
|----------|----------|
| (A) 64 K | (B) 16 K |
| (C) 4 K  | (D) 1 K  |
44. 把 CPU 的時間切割成許多小片段，輪流分配給每個使用者的每個工作，這種系統名稱為何？
- (A) 分散式系統
  - (B) 平行處理系統
  - (C) 批次系統
  - (D) 分時系統
45. 執行下列程式後，其最後的 S 及 I 的值，將  $S+I = ?$
- ```

S=0
FOR I=1 TO 10
S=S+I
NEXT I
    
```
- (A) 55
  - (B) 56
  - (C) 65
  - (D) 66

【以下空白】

# 105 學年度四技二專第二次聯合模擬考試

## 電機與電子群資電類 專業科目(二) 詳解

105-2-04-5

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B  | D  | C  | A  | B  | D  | A  | C  | C  | A  | B  | A  | D  | D  | A  | C  | B  | D  | C  | A  | D  | A  | B  | B  | C  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D  | D  | C  | C  | A  | D  | B  | B  | A  | C  | C  | B  | C  | A  | A  | D  | B  | C  | D  | D  | B  | A  | B  | C  | B  |

**第一部分：數位邏輯**

1. (B) 正弦波為連續信號，為類比信號
2. 電腦系統為二進制，使用 2 的補數處理減法運算
3.  $2^{10} = 1024 > 1000$
4. 如真值表為正邏輯的 OR，相當為負邏輯的 AND

| 正邏輯 |   |   | 負邏輯 |   |   |   |   |
|-----|---|---|-----|---|---|---|---|
| A   | B | C | Y   | A | B | C | Y |
| 0   | 0 | 0 | 0   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0   | 0 | 1 | 1   | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0   | 1 | 0 | 1   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0   | 1 | 1 | 1   | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1   | 0 | 0 | 1   | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1   | 0 | 1 | 1   | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1   | 1 | 0 | 1   | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1   | 1 | 1 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. C 為 Low 動作，故 C=0，閘才會正常動作
6.  $\overline{ABC} + \overline{ABC} = (\overline{ABC}) \cdot (\overline{ABC}) = (\overline{AB} + \overline{C})(\overline{AB} + \overline{C}) = (\overline{AB} + \overline{C})(AB + \overline{C}) = \overline{ABC} + ABC + \overline{C}$

7. ①AND 閘： $(AB)C = A \cdot (BC)$  符合結合律

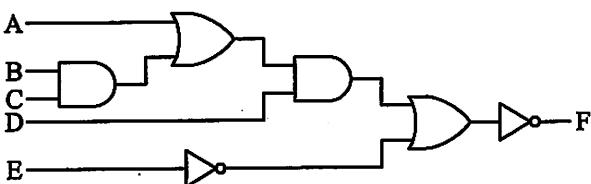
②NAND 閘： $\overline{ABC} \neq \overline{ABC}$

$$\because \overline{ABC} = AB + \overline{C}, \overline{ABC} = \overline{A} + BC$$

8.

|   |     |    |   |
|---|-----|----|---|
|   |     | 01 |   |
| X | (X) | X  | X |
|   | 1   |    |   |

9. ∵ 輸入列輸出最多需經過 5 個邏輯閘  
 $= 3 \text{ ns} \times 5 = 15 \text{ ns}$



10. 將 NAND 閘改成反相輸出的 OR 閘，即可求出答案
11. NOR、NAND 為萬用閘，多工器可由輸入線和選擇線來設計

|       |   |   |   |       |       |
|-------|---|---|---|-------|-------|
| 12. D | C | B | A | $Y_1$ | $Y_0$ |
| 1     | x | x | x | 1     | 1     |
| 0     | 1 | x | x | 1     | 0     |
| 0     | 0 | 1 | x | 0     | 1     |
| 0     | 0 | 0 | 1 | 0     | 0     |

$$Y_1 = D + \overline{DC} = D + C$$
**第二部分：數位邏輯實習**

15. 不需裝電池，也可測試出脈波狀態
16. 緩衝器類似電壓隨耦器  $A_v = 1, A_i \gg 1$

17. TTL 的典型值

$$V_{IH} = 2 \text{ V}, V_{IL} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{OH} = 2.4 \text{ V}, V_{OL} = 0.4 \text{ V}$$

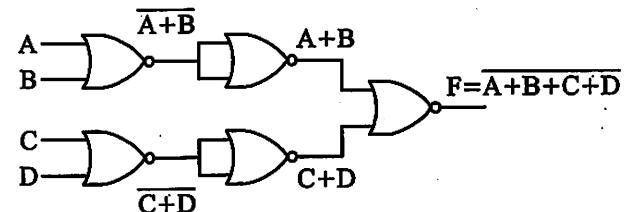
$$18. \text{Fan out}(H) = \frac{200u}{20u} = 10$$

$$\text{Fan out}(L) = \frac{24m}{2m} = 12$$

取小值 = 10

$$19. \overline{A \cdot \overline{B}} = A + B$$

$$20. F = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}}$$

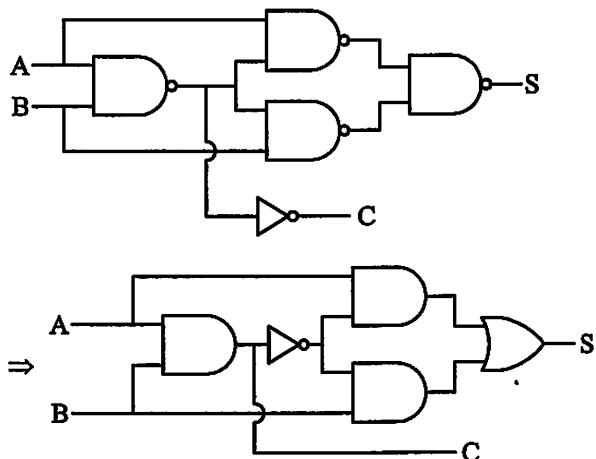


$$21. G_1 = BC, G_2 = A + G_1 \\ G_3 = \overline{G_1 + D}, G_4 = Z = G_2 \cdot G_3$$

| 輸入信號    | 正常狀況<br>各閘的輸出  |                |                |                | G <sub>2</sub> = 1 情況<br>各閘的輸出 |                  |                  |                  |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | G <sub>1</sub> | G <sub>2</sub> | G <sub>3</sub> | G <sub>4</sub> | G <sub>1</sub> '               | G <sub>2</sub> ' | G <sub>3</sub> ' | G <sub>4</sub> ' |
| A B C D | G <sub>1</sub> | G <sub>2</sub> | G <sub>3</sub> | G <sub>4</sub> | G <sub>1</sub> '               | G <sub>2</sub> ' | G <sub>3</sub> ' | G <sub>4</sub> ' |
| 0 0 0 0 | 0              | 0              | 1              | 0              | 0                              | 1                | 1                | 1                |
| 0 0 1 1 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                              | 1                | 0                | 0                |
| 1 0 0 1 | 0              | 1              | 0              | 0              | 0                              | 1                | 0                | 0                |
| 0 1 1 1 | 1              | 1              | 0              | 0              | 1                              | 1                | 0                | 0                |

由上表可知，當 ABCD = 0000 時， $G_4 \neq G_4'$

$$22. S = A \oplus B, C = AB$$



23. 執行  $B - A$ ,  $\therefore B$  為被減數

$$24. F = AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$25. \begin{array}{cccccccccc} A_{15} & A_{14} & A_{13} & A_{12} & A_{11} & A_{10} & A_9 & A_8 & A_7 & \sim A_0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & \dots 1 \end{array}$$

$= 2800H \sim 2BFFH$

### 第三部分：電子學實習

27. 正弦波全週的平均值 = 0 V

28. 切到 DC 位置可量測含直流位準的交流波形

29.  $V_i > 6V$ ,  $D_1$  OFF,  $D_2$  ON,  $V_o = 6V$

$$-18V \leq V_i \leq 6V, D_1$$
 OFF,  $D_2$  ON,  $V_o = \frac{6+V_i}{2}$

$$V_i < -18V, D_1$$
 ON,  $D_2$  ON,  $V_o = -6V$

$$V_{o(P-P)} = 12V_{P-P}$$

30.  $\because$  Sat 時,  $I_B \times \beta \geq I_C(\text{sat})$

31. B 極寬度小,  $\beta \uparrow$ , 易 Sat

32.  $\because$  Q 點在靠近截止區, 使  $V_{o(\text{dc})} \uparrow$ , 故  $V_o$  正半週易失真

33.  $C_E$  在交流時視為短路, 故可提高  $A_v$

34.  $f \downarrow X_C \uparrow V_o \downarrow A_v \downarrow$

35. 達靈頓為直接交連, 穩定性差

36. (A)  $\because |V_{GS}| > |V_P|$ ,  $\therefore$  為 OFF 區

(B)  $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = -1$ ,  $V_{GD} > V_P$ ,  $\therefore$  為歐姆區

(C)  $V_{GD} = 0 - 1 = -1$ ,  $V_{GD} > V_P$ ,  $\therefore$  為歐姆區

(D)  $V_{GD} = -1 - 3 = -4$ ,  $V_{GD} < V_P$ ,  $\therefore$  為 Sat 區

37.  $R_i$  高可使避免輸入信號衰減

### 第四部分：計算機概論

42. SRAM 為靜態的 RAM

43. BCIF-AC20+1=1000<sub>(10)</sub>=16<sup>3</sup>=2<sup>12</sup>=4K

45.  $S = 1+2+\dots+10 = 55$ ,  $I = 11$ ,  $S+I = 66$

46.  $270 \times 1024 \times 8 + 320 \div 288 = 24 \text{ bit}$

50. mpg 為影片檔